

TB67S105FTG 使用上の注意点

概要

TB67S105FTG は、PWM チョッパ型 2 相バイポーラ駆動、8 ビットシリアル制御方式のステッピングモータドライバです。BiCD プロセスにより、出力耐圧 50 V、最大電流 3.0 A を実現しています。また、レギュレータを内蔵しているため VM 単一電源でモータを駆動できます。さらに、IC 内部に 8 ビットシフトレジスタを内蔵しており、シリアルーパラレル変換に対応しています。

本資料に含まれる情報につきましては動作 / 特性を保証するものではありません。(評価を行う上での参考資料です。) 電気的特性など、詳細につきましては製品仕様書をご確認いただきますようお願いします。

目次

概要	1
1. 電源電圧.....	3
1.1 電源電圧と動作範囲	3
1.2 電源シーケンス	3
2. モータ電流について	3
3. 制御入力について	3
4. 応用回路例	4
5. IC の消費電力について	7
6. 評価基板図面	8
6.1 入力関連.....	8
6.2 主要部品関連.....	9
6.3 基板オプション関連	10
6.4 2 基板の接続について	11
7. 参考ランドパターン例	12
8. タイミングチャート例	13
使用上のご注意およびお願い事項	16
製品取り扱い上のお願い.....	17

1. 電源電圧

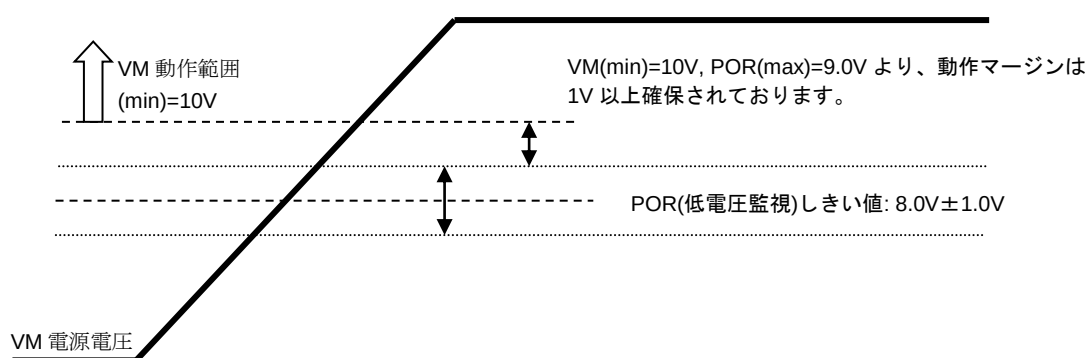
1.1 電源電圧と動作範囲

TB67S105FTG をご使用いただくにあたり、IC へは VM, VREFA, VREFB の端子へ電圧印加が必要になります。

VM 電源電圧の絶対最大定格は 50 V ですが、動作範囲：10 ~ 40 V の範囲内でご使用ください。

VREF 電圧の絶対最大定格は 5 V ですが、動作範囲：0 ~ 3.6 V の範囲でご使用ください。

なお、VREF 電圧につきましては IC 内部レギュレータの電圧(VCC)をご使用いただくことも可能です。(ただし内部レギュレータの能力以上に電流を引くと、VCC のレギュレーションを保持できなくなる可能性があります。VCC 電圧を分圧して VREF 電圧としてご使用される場合には、分圧抵抗の合計が 10 k Ω 未満としないようご注意ください。)



1.2 電源シーケンス

TB67S105FTG には、低電圧監視回路(POR)を内蔵しているため電源投入 / 遮断時の手順は特に必要ありません。ただし VM 電圧の不安定な、電源立ち上げ / 立ち下げ(過渡領域)時にはモータ動作を OFF 状態にすることを推奨します。電源電圧が安定な状態になってから入力信号を切り替えてモータを動作させてください。

2. モータ電流について

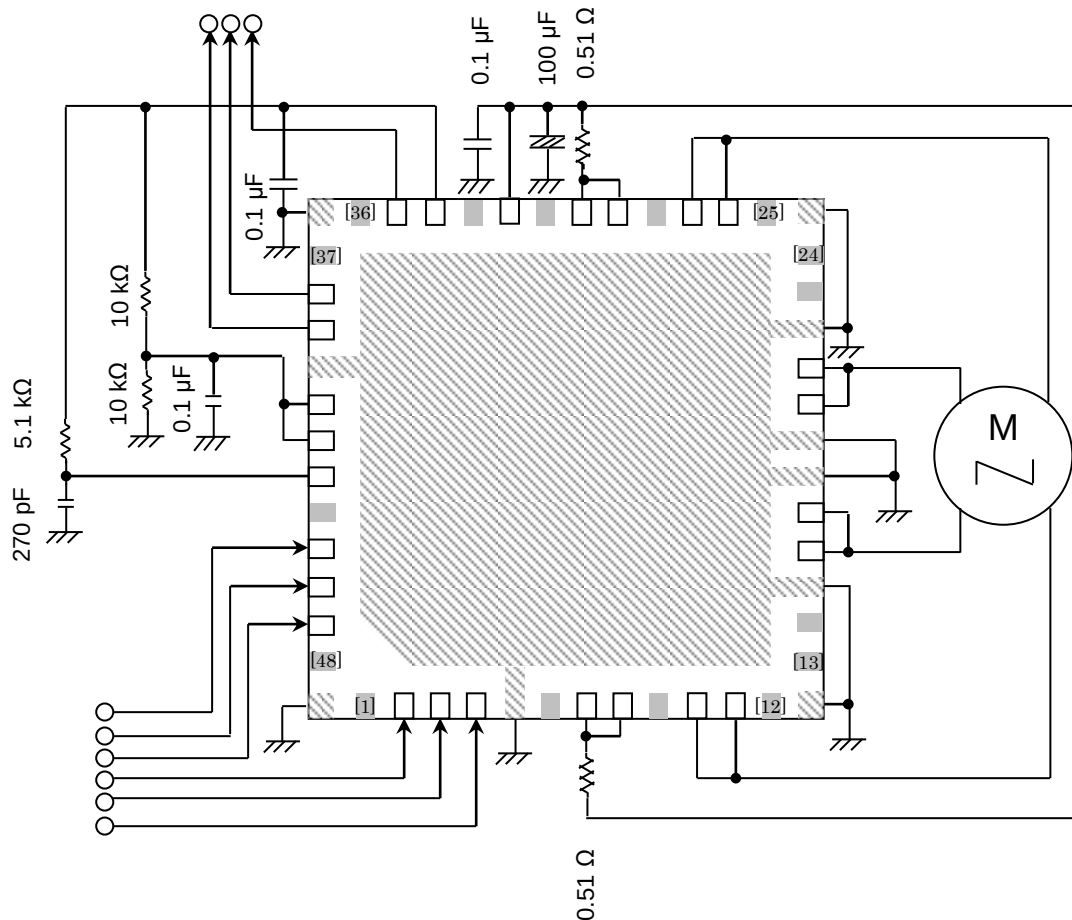
モータの電流は動作範囲: 2.4 A 以下でご使用ください。また使用条件(周囲環境温度や基板配線、放熱経路、励磁設計など)によって実際に使用可能な最大電流値が制限されます。動作環境下で熱計算/実評価の上最適な電流値に設定いただきますようお願いします。

3. 制御入力について

VM 電圧が供給されていない状態でロジック入力信号が入力された場合でも、信号入力による起電力は発生しない構成となっておりますが、1.2項「電源シーケンス」記載の内容をご参考に電源投入前は入力信号も Low レベルに設定いただくことを推奨します。

4. 応用回路例

(各素子の定数はご参考値です。)



* 斜線部は GND ピン / エリア、灰色部は NC ピンです。

注：必要に応じて、バイパスコンデンサの追加を推奨します。GND 配線は、できる限り 1 点接地になるようお願いします。OUT 端子(A+,A-,B+,B-)、RS 端子(RSA,RSB)はそれぞれ 2 ピンありますので、同一ピン同士は必ずショートしてご使用ください。

注：パッケージの四隅(コーナ PAD)は必ず基板の GND パターンに接地いただきますようお願いします。

応用回路例は、参考例であり、量産設計に際しては、十分な評価を行ってください。
また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

(1) 電源端子用コンデンサについて

IC に印加いただく電源電圧安定化、およびノイズリジェクトのため各端子へ適切な値のコンデンサを接続してください。

なお、コンデンサはできるだけ IC の近くに接続いただくことを推奨します。特にセラミックコンデンサを IC 近傍に配置いただくことで高周波数の電源変動やノイズを抑えることに効果的です。

推奨値

項目	部品	標準値	推奨範囲
VM - GND 間	電解コンデンサ	100 μ F	47 ~ 100 μ F
	セラミックコンデンサ	0.1 μ F	0.01 ~ 1 μ F
VCC - GND 間	セラミック / 電解コンデンサ	0.1 μ F	0.01 ~ 1 μ F
(VREF - GND 間)	セラミックコンデンサ	0.1 μ F	0.01 ~ 1 μ F

* VREF - GND 間のご使用環境に合わせ、必要に応じてコンデンサ接続をご検討ください。

* モータ負荷条件や基板パターンなどによっては、各部品を省く、推奨値以外のコンデンサを使用する、なども可能です。

(2) 電流検出抵抗について

本 IC では、VM-RS 端子間に電流検出抵抗を挿入いただくことで定電流検出しきい値を設定します。

なお、検出抵抗は IC の近くに接続いただくことを推奨します。(基板の配線抵抗などの影響を抑えることができ、より設定値に近い電流(電流精度の高い状態)でモータを制御することができます。)

推奨値

項目	部品	標準値	推奨範囲
VM - RS 間	チップ / リード抵抗	0.22 Ω (1.2 A ~ 2.4 A)	0.22 ~ 1.0 Ω
VM - RS 間	チップ / リード抵抗	0.51 Ω (0 A ~ 1.2 A)	0.22 ~ 1.0 Ω

定電流検出しきい値、Vref 電圧、RS 検出抵抗の関係式は以下のとおりです。

$$I_{out(max)} = V_{ref(gain)} \times \frac{V_{ref(V)}}{R_{RS}(\Omega)}$$

Vref(gain) : Vref 減衰比は 1 / 5.0 (typ.) です。

なお、電流検出抵抗につきましては推奨範囲以外の定数でもご使用いただけます。ただし抵抗値が小さい場合、大きい場合には下記点をご注意ください。

- 検出抵抗を小さくすることで、内部の基準電圧と比較する VM - RS 間の差電圧が小さくなるため、設定電流値に対する誤差が大きくなる場合があります。
- 検出抵抗を大きくすることで、モータ動作時に検出抵抗にかかる電力が増える($P = I^2 \times R$)ため、抵抗値が小さいものと比較し同じ電流を流す場合は、電力許容値の大きなものを使う必要があります。

(3) 周波数設定部品について

OSCM 発振周波数 (f_{OSCM}) とチョッピング周波数 (f_{chop}) は以下の式で計算できます。

$$f_{OSCM} = 1 / [0.56 \times \{C \times (R1 + 500)\}]$$

.....C,R1 : OSCM 用外付け定数(C = 270 pF , R1 = 5.1 k Ω (参考定数))

$$f_{chop} = f_{OSCM} / 16$$

チョッピング周波数を上げた場合、電流の脈流分が減少するため波形の再現性はあがりますが、IC 内部のゲート損失が上昇するため、発熱が大きくなります。

チョッピング周波数を下げる事により発熱の減少が期待できますが、電流脈流分が増える可能性があります。

一般的には 70kHz 程度の周波数を基準にし、50 kHz から 100 kHz 程度の周波数範囲で設定される事を推奨します。

(4) 電源 / GND 用配線パターンについて

特に VM,RS,GND パターンへは大電流が流れることが想定されるため、配線インピーダンスなどの影響を受けないよう十分な配線パターンを確保いただきますようお願いいたします。また面実装パッケージ品は、IC 裏面の放熱板から基板 GND へ熱を逃がすことが極めて重要になるため、熱設計を考慮したパターン設計をしてください。

(5) ヒューズについて

過電流の発生や IC が故障した場合などにおいて、継続的に大電流が流れ続けることの無いよう、電源ラインへは適切なヒューズを挿入の上ご使用ください。IC は、絶対最大定格を超えた使い方、誤った配線、および配線や負荷から誘起される異常パルスノイズなどが原因で破壊することがあり、この結果 IC に大電流が流れ続けることで発煙や発火に至ることがあります。破壊における大電流の流入を想定し、影響を最小限にするため、ヒューズの容量や溶断時間、挿入回路位置などの適切な設定が必要となります。

本 IC には出力に過大な電流が流れたことを検出し、出力を OFF にする過電流検出回路(ISD)が内蔵されていますが、あらゆる条件で IC の保護を保証するものではありません。異常検出回路動作後は速やかに過電流状態を解除するようお願いいたします。絶対最大定格を超えた場合など、ご使用方法や状況により過電流検出回路が正常に動作しないことや、動作する前に IC が破壊する可能性があります。また、過電流が流れ続けた場合、ご使用方法や状況によっては IC が発熱などにより破壊することがあります。過電流状態が継続した場合に、2 次破壊が懸念されることや、ノイズによる誤動作を防止するため、過電流検出回路に不感帯時間をもつことから、出力負荷条件によって必ずしも動作しないことが懸念されます。万が一のことを考慮し、異常状態が継続することを避けるため、電源へのヒューズ使用をお願いいたします。

5. IC の消費電力について

IC が消費する電力については、大枠、出力部のトランジスタが消費する電力とロジック部の消費する電力の 2 つの部分に分けることができます。

$$P(\text{total}) = P(\text{out}) + P(\text{bias})$$

- モータ出力部の消費電力

出力部の電力(P(out))は H-Bridge 上下の MOSFET によって消費されます。

$$P(\text{out}) = \text{H-Bridge 数} \times I_{\text{out}}(\text{A}) \times V_{\text{DS}}(\text{V}) = 2(\text{ch}) \times I_{\text{out}}(\text{A}) \times I_{\text{out}}(\text{A}) \times R_{\text{on}}(\Omega) \quad (1)$$

モータ出力の電流波形が理想波形(2 相励磁 / 矩形波)になった場合に、出力部の平均電力は以下のとおり計算できます。

$$\begin{aligned} R_{\text{on}} &= 0.6\Omega, I_{\text{out}}(\text{peak: Max}) = 1.0 \text{ A}, V_{\text{M}} = 24 \text{ V} \text{ とすると下記のように計算できます。} \\ P(\text{out}) &= 2(\text{ch}) \times 1.0(\text{A}) \times 1.0(\text{A}) \times 0.6(\Omega) \dots\dots\dots (2) \\ &= 1.2(\text{W}) \end{aligned}$$

- ロジックと IM 系の消費電力

ロジックと IM 系の消費電力は動作時と停止時に分けて計算します。

$$\begin{aligned} I(\text{IM3}) &= 5.5 \text{ mA (typ.)} && \text{動作時} \\ I(\text{IM2}) &= 3.5 \text{ mA (typ.)} && \text{停止時} \end{aligned}$$

出力系は、VM (24V) に接続されています。(出力系：VM に接続される回路により消費される電流と出力段がスイッチングすることにより消費される電流の合計)

消費電力は以下のように計算できます。

$$\begin{aligned} P(\text{bias}) &= 24(\text{V}) \times 0.0055(\text{A}) \dots\dots\dots (3) \\ &= 0.132(\text{W}) \end{aligned}$$

- 消費電力

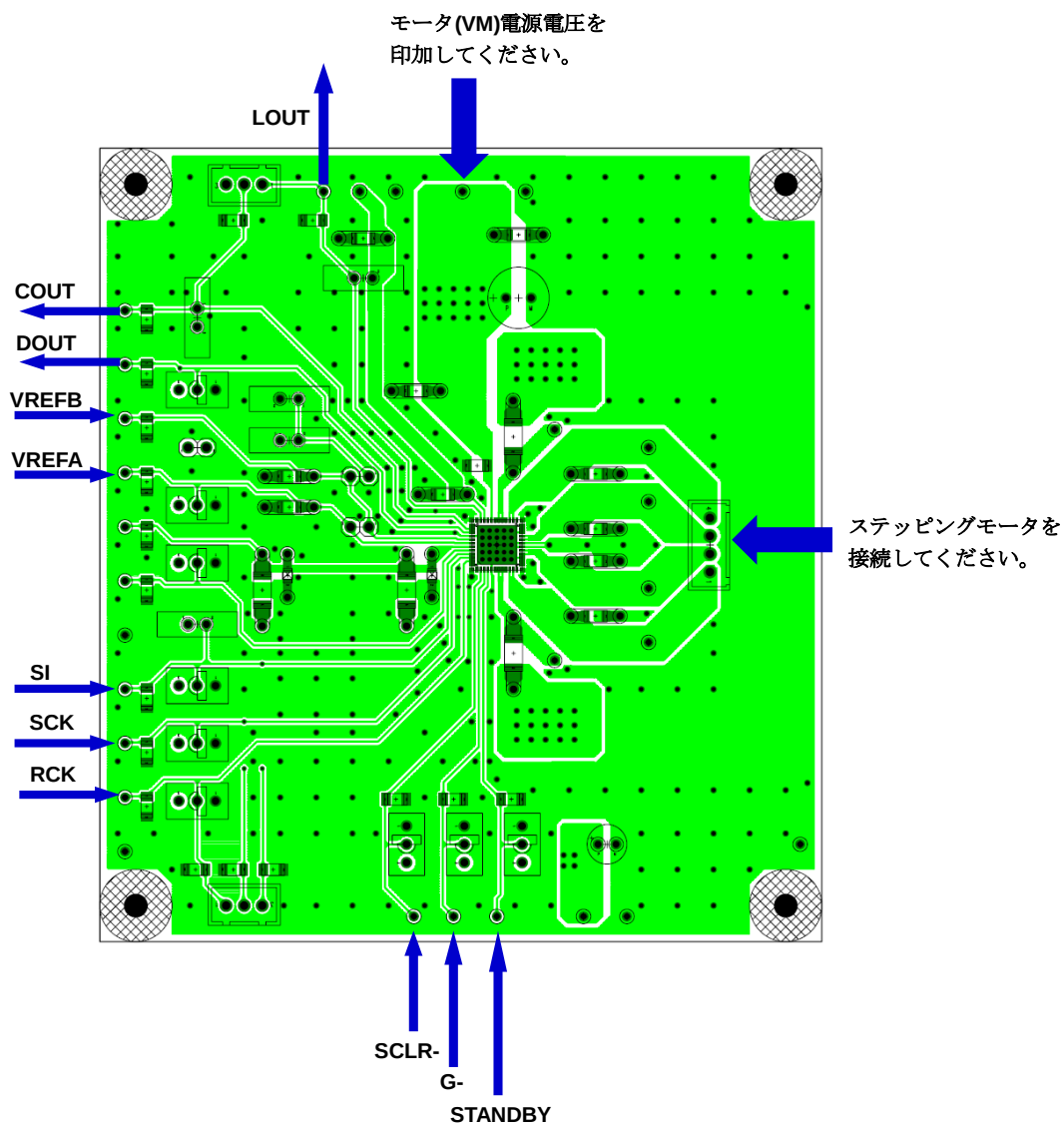
計算式(2)、(3)の値から最終的な消費電力 P(total)は、以下のように計算できます。

$$P(\text{total}) = P(\text{out}) + P(\text{bias}) = 1.2 + 0.132 = 1.332(\text{W}) \text{ となります。}$$

なお実際のモータ動作においては、電流ステップの遷移時間や定電流 PWM によるリップルなどによって平均電流は計算値より低くなります。上記計算値をご参考に、基板などにおける熱設計に関して十分実装評価を行った上、マージンをもって設定いただきますようお願いします。

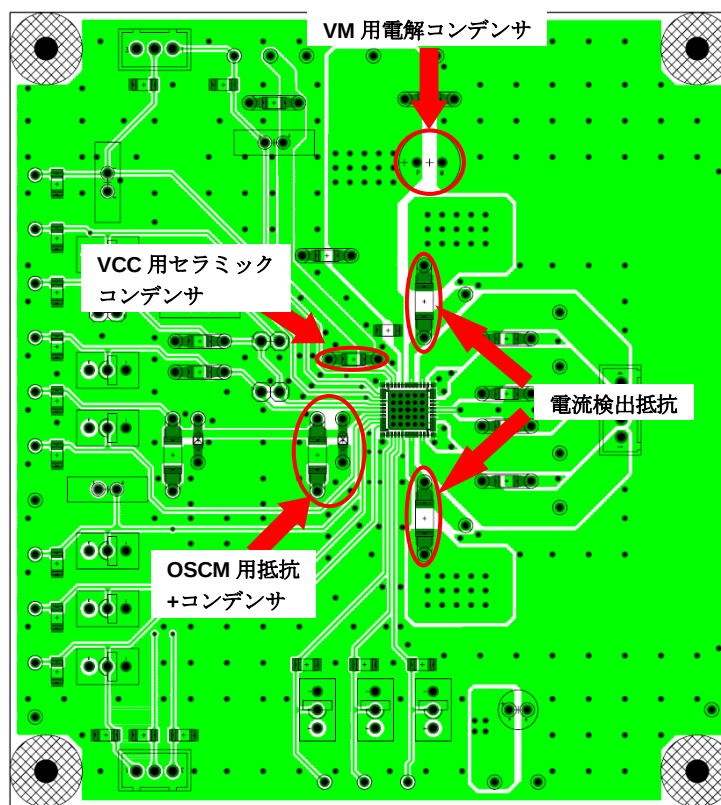
6. 評価基板図面

6.1 入力関連



各電源、制御信号を上図のとおり入力してください。

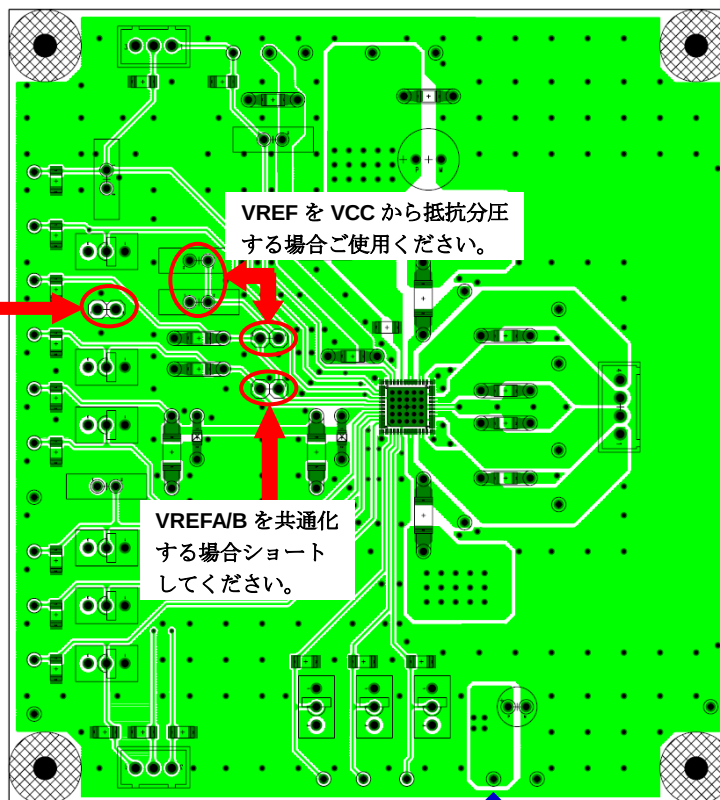
6.2 主要部品関連



p.10 を参考に各部品を接続してください。

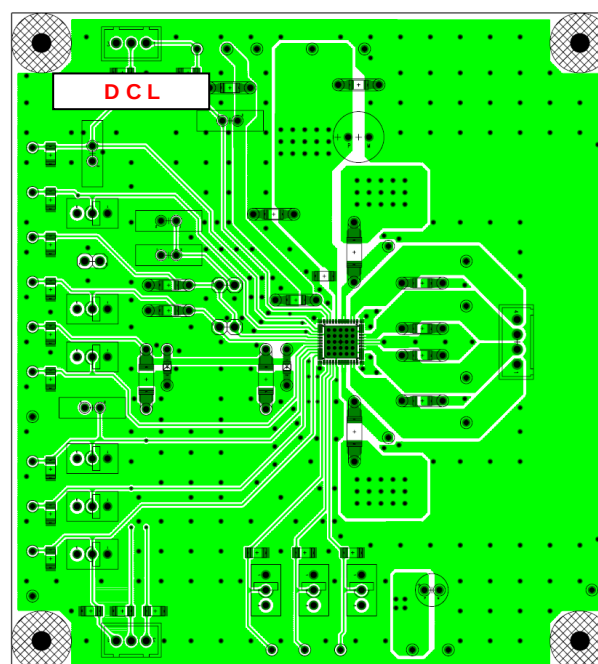
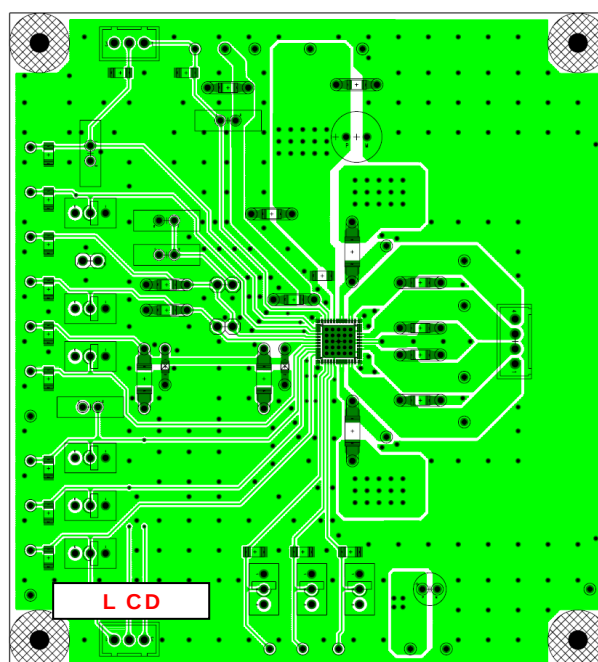
6.3 基板オプション関連

スイッチ用電源として VCC
を使用する場合ジャンパを
接続してください。



スイッチ用電源印加端子
(必要に応じて 3.3 V or 5 V を印加してください。)
* スイッチ用電源として VCC を使用される場合、
VDD への電圧印加は行わないでください。

6.4 2 基板の接続について

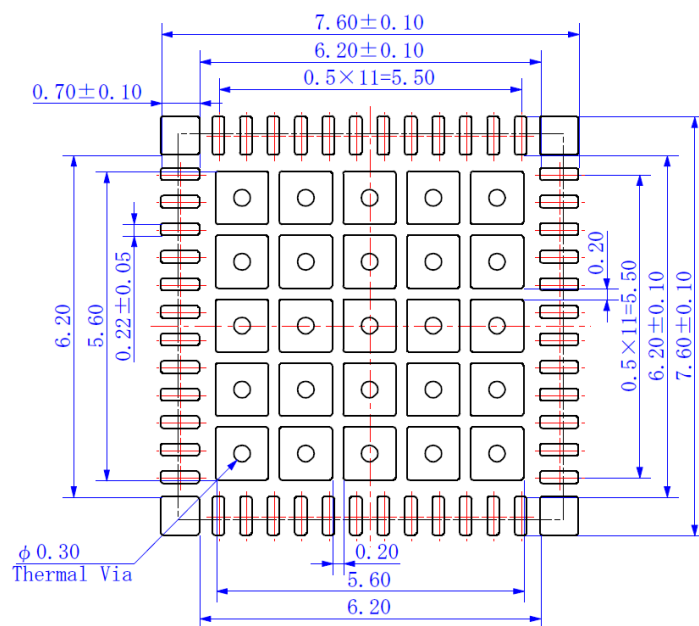


D(シリアルデータ)、C(シリアルクロック)、L(シリアルラッチ)のコネクタ配置は上図のとおりとなっております。

IC1 の 3 線シリアル出力を IC2 の 3 線シリアル入力としてご使用いただく場合、おのこの D,C,L を正しく接続いただきますようお願いします。

7. 参考ランドパターン例

WQFN48 ランドパターン例

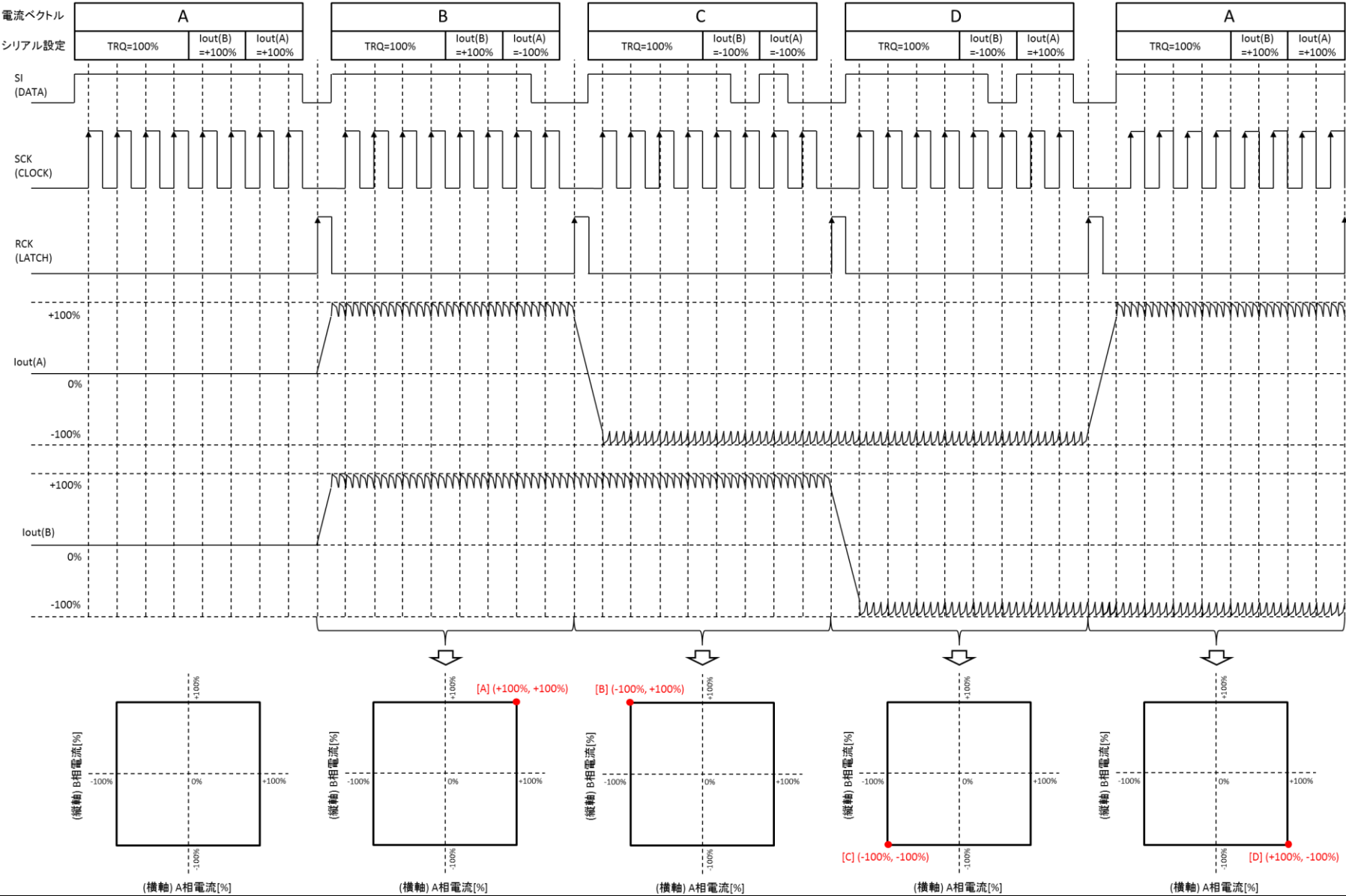


ランドパターン例は参考例であり、量産設計を保証するものではありません。

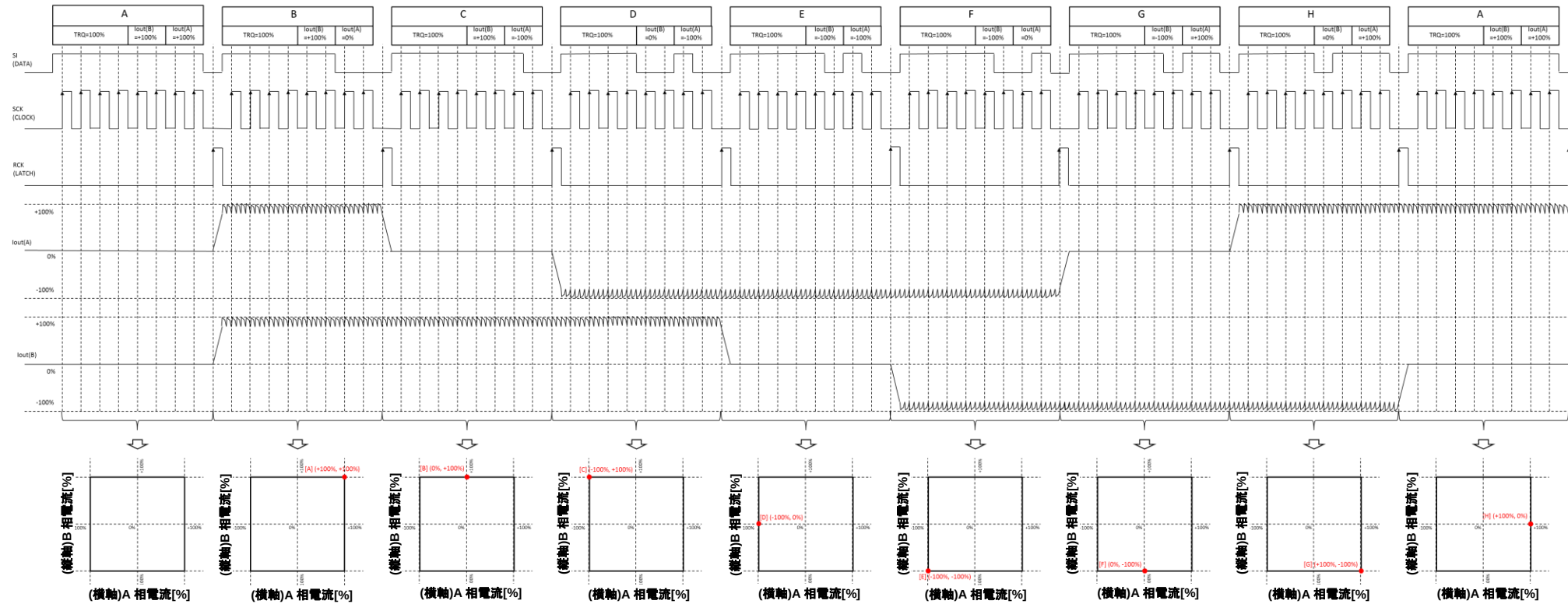
実装基板の寸法設定の際には、半田ブリッジ / 半田接合強度 / 基板製作時のパターン精度 / IC 搭載機の搭載精度などを十分考慮頂き、最適パターンを決定してください。

8. タイミングチャート例

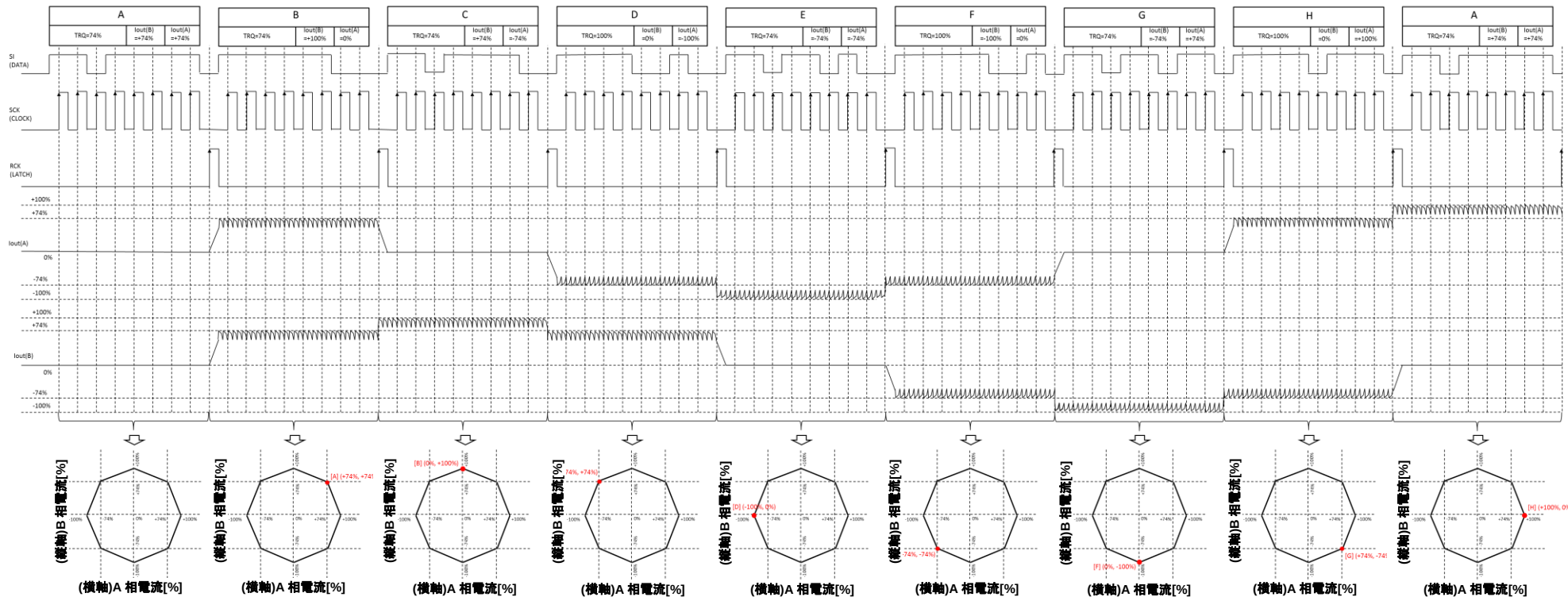
タイミングチャート例(2相励磁、CW制御)



タイミングチャート例(1-2相(a)励磁、CW制御)



タイミングチャート例(1-2 相(b)励磁、CW 制御)



使用上のご注意およびお願い事項

使用上の注意事項

絶対最大定格は複数の定格の、どの1つの値も瞬時たりとも超えてはならない規格です。

複数の定格のいずれに対しても超えることができません。

絶対最大定格を超えると破壊、損傷および劣化の原因となり、破裂・燃焼による傷害を負うことがあります。

デバイスの逆差し、差し違い、または電源のプラスとマイナスの逆接続はしないでください。電流や消費電力が絶対最大定格を超え、破壊、損傷および劣化の原因になるだけでなく、破裂・燃焼により傷害を負うことがあります。なお、逆差しおよび差し違いのままで通電したデバイスは使用しないでください。

過電流の発生や IC の故障の場合に大電流が流れ続けないように、適切な電源ヒューズを使用してください。IC は絶対最大定格を超えた使い方、誤った配線、および配線や負荷から誘起される異常パルスノイズなどが原因で破壊することがあり、この結果、IC に大電流が流れ続けることで、発煙・発火に至ることがあります。破壊における大電流の流出入を想定し、影響を最小限にするため、ヒューズの容量や溶断時間、挿入回路位置などの適切な設定が必要となります。

モータの駆動など、コイルのような誘導性負荷がある場合、ON 時の突入電流や OFF 時の逆起電力による負極性の電流に起因するデバイスの誤動作あるいは破壊を防止するための保護回路を接続してください。IC が破壊した場合、傷害を負ったり発煙・発火に至ることがあります。

保護機能が内蔵されている IC には、安定した電源を使用してください。電源が不安定な場合、保護機能が動作せず、IC が破壊することがあります。IC の破壊により、傷害を負ったり発煙・発火に至ることがあります。

パワーアンプおよびレギュレータなどの外部部品（入力および負帰還コンデンサなど）や負荷部品（スピーカなど）の選定は十分に考慮してください。

入力および負帰還コンデンサなどのリーク電流が大きい場合には、IC の出力 DC 電圧が大きくなります。この出力電圧を入力耐電圧が低いスピーカに接続すると、過電流の発生や IC の故障によりスピーカの発煙・発火に至ることがあります。（IC 自体も発煙・発火する場合があります。）特に出力 DC 電圧を直接スピーカに入力する BTL (Bridge Tied Load) 接続方式の IC を用いる際は留意が必要です。

使用上の留意点

過電流検出回路

過電流検出回路 (ISD) はどのような場合でも IC を保護するわけではありません。動作後は、速やかに過電流状態を解除するようお願いします。

絶対最大定格を超えた場合など、ご使用方法や状況により、過電流検出回路が正常に動作しなかったり、動作する前に IC が破壊したりすることがあります。また、動作後、長時間過電流が流れ続けた場合、ご使用方法や状況によっては、IC が発熱などにより破壊することがあります。

過熱検出回路

過熱検出回路 (TSD) は、どのような場合でも IC を保護するわけではありません。動作後は、速やかに過熱状態を解除するようお願いします。

絶対最大定格を超えて使用した場合など、ご使用法や状況により、過熱検出回路が正常に動作しなかったり、動作する前に IC が破壊したりすることがあります。

放熱設計

パワーアンプ、レギュレータ、ドライバなどの、大電流が流出入する IC の使用に際しては、適切な放熱を行い、規定接合温度 (T_j) 以下になるように設計してください。これらの IC は通常使用時においても、自己発熱をします。IC 放熱設計が不十分な場合、IC の寿命の低下・特性劣化・破壊が発生することがあります。また、IC の発熱に伴い、周辺に使用されている部品への影響も考慮して設計してください。

逆起電力

モータを逆転やストップ、急減速を行った場合に、モータの逆起電力の影響でモータから電源へ電流が流れ込みますので、電源の Sink 能力が小さい場合、IC の電源端子、出力端子が定格以上に上昇する恐れがあります。逆起電力により電源端子、出力端子が定格電圧を超えないように設計してください。

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。